

Literatura :

- 1/ Krejčířík A.: Technologie materiálů, skriptum ČVUT FEL, Praha 1987
- 2/ Krejčířík A.: Technologie materiálů - příklady technologií, skriptum ČVUT FEL, Praha 1986
- 3/ Ghandhi S.K.: VLSI Fabrication Principles, J.Wiley and Sons, New York 1983
- 4/ Blanchard R., Gise P.: Modern semiconductor fabrication technology, Prentice Hall, New Jersey, 1986
- 5/ Adamčik I.: Základní vlastnosti unipolárních integrovaných obvodů, výzkumná zpráva Tesla VUST, Praha 1984
- 6/ Selberher S.: Analysis and Simulation of Semiconductor Devices, Springer Verlag, Wien 1984
- 7/ Křemík 88 : Sborník příspěvků z koference 1988, Rožnov pod Radhoštěm
- 8/ Antoniadis D.A., Hansen S.E., Dutton R.W.: Suprem II - program for IC process modeling and simulation, Technical report No.5019-2, Army Research Office, Stanford CA, 1978
- 9/ Loureiro A.P., Conde O., Vilar R.: Surface Engineering with High Energy Beams, sborník referátů z koference v Lisabonu, Portugalsko, 1989
- 10/ Trivedi R. et al.: Principles of Solidification and Material Processing, Indo-US workshop, Hyderabad 1988
- 11/ Pouch J.J., Alterovitz S.A.: Synthesis and Properties of Boron Nitride, Materials and Sciences Forum, Vol 54 and 55
- 12/ Singh N.B., Laxmanan V., Collings E.W.: Materials Processing in Space, Materials Science Forum Vol.50, Chicago, USA, 1989
- 13/ Lendvay E.E.: Epitaxial Crystal Growth, koference v Budapešti, 1990
- 14/ Minchev E.G., Pramatarova L.: Molecular Beam Epitaxy, 3. symposium Velké Tar-novo, Bulharsko 1989
- 15/ Kordoš E.P.: Gallium Arsenide III, sborník 3. koference A^{III}B^V polovodičů, Lomnice, ČSFR 1988
- 16/ Wöhlbier E.F.H.: Ion Implantatio 1988, Defect and Diffusion Forum, 1988
- 17/ Laskar E.A. et al.: Diffusion in Solids, koference Bombay, India, 1984
- 18/ Gupta D., Romig A.D., Dayananda M.A.: Diffusion Process in High Technology Materials, symposium Cincinnati 1987